

	TPS1101DRG4
	Número de pieza del fabricante: TPS1101DRG4
	Fabricante / Marca: N/A
	Parte de la descripción: MOSFET P-CH 15V 2.3A 8-SOIC
	Estado de RoHs: Sin plomo / Cumple con RoHS
	Condición de stock: New original, 10267 pcs Stock Available.
	Nave de: Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Manera de envío: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Presupuesto	
Número de pieza	TPS1101DRG4
Fabricante	N/A
Descripción	MOSFET P-CH 15V 2.3A 8-SOIC
Categoría	Productos Semiconductores Discretos > Transistores-
Estado de la pieza	10267 pcs Stock
VGS (th) (Max) @Id	1.5V @ 250µA
Tecnología	MOSFET (Metal Oxide)
Paquete del dispositivo	8-SOIC
Serie	-
RDS (Max) @Id, Vgs	90 mOhm @ 2.5A, 10V
La disipación de energía (máximo)	791mW (Ta)
embalaje	Tape & Reel (TR)
Paquete / Cubierta	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ 150°C (TJ)
Tipo de montaje	Surface Mount
Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds	-
Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs	11.25nC @ 10V
Tipo FET	P-Channel
Característica de FET	-
Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las	15V
Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C	2.3A (Ta)

Usted también puede estar interesado

en:



TPS1120DG4
N/A
MOSFET 2P-CH 15V 1.17A 8-SOIC



TPS1110DR
TI
TPS1110DR TI



TPS1100PWR
N/A
MOSFET P-CH 15V 1.27A 8-TSSOP



TPS1101D
N/A
MOSFET P-CH 15V 2.3A 8-SOIC



TPS1100YD
TI
TPS1100YD TI



TPS1101DR
N/A
MOSFET P-CH 15V 2.3A 8-SOIC



TPS1120D
N/A
MOSFET 2P-CH 15V 1.17A 8-SOIC



TPS1101DRG4 MOS
VBSEMI
VBSEMI SOP-8

TPS1101DRG4 Palabra clave	Más			
relacionada				
TPS1101DRG4 electrónico	Hoja de datos TPS1101DRG4	Hojas de datos TPS1101DRG4	TPS1101DRG4 PDF	TPS1101DRG4
Precio TPS1101DRG4	Componentes TPS1101DRG4	Distribuidor TPS1101DRG4	Imagen TPS1101DRG4	Parte TPS1101DRG4
TPS1101DRG4 Nuevo	Fabricante TPS1101DRG4	Imagen TPS1101DRG4	Stock TPS1101DRG4	Inventario TPS1101DRG4
	TPS1101DRG4 Original	TPS1101DRG4 garantizado	TPS1101DRG4 RFQ	TPS1101DRG4 Orden en línea